

課題番号 : F-17-NM-0066  
利用形態 : 機器利用  
利用課題名 (日本語) : ゲート特性の評価  
Program Title (English) : Evaluation of gate characteristics  
利用者名 (日本語) : 竹内克彦  
Username (English) : K. Takeuchi  
所属名 (日本語) : ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社  
Affiliation (English) : Sony Semiconductor Solutions Corporation  
キーワード/Keyword : 半導体、HEMT、トランジスタ、リソグラフィ・露光・描画装置

## 1. 概要 (Summary)

化合物半導体材料は、絶縁破壊電圧が高い、高温動作が可能、飽和ドリフト速度が高いなどの特徴を有している。また、ヘテロ接合に形成される二次元電子ガス (2DEG) は、移動度が高くかつシート電子密度が高いという特徴がある。これらの特徴により、高電子移動度トランジスタ (HEMT: High Electron Mobility Transistor) が、広く利用されている。HEMT は低抵抗、高速、高耐圧動作が可能のため、パワーデバイスや RF デバイスなどへの適用が期待されている。

今回、トランジスタのオフ特性の確認を目的として、ゲート、ソースおよびドレインを作製するプロセス検討を行った。

## 2. 実験 (Experimental)

### 【利用した主な装置】

- ・ 125kV 電子ビーム描画装置
- ・ 高速マスクレス露光装置
- ・ 12 連電子銃型蒸着装置
- ・ プラズマ CVD 装置
- ・ 多目的ドライエッチング装置
- ・ 化合物ドライエッチング装置
- ・ FIB-SEM ダブルビーム装置
- ・ 室温プローバスシステム

### 【実験方法】

当社で準備したウエハに、上記装置を使用して、ゲート電極およびソース/ドレイン電極を形成して、CV 評価用のデバイスを作製した。ゲート-ソース(ドレイン)間の 2 端子間の CV 測定を室温プローバスシステムにて行い、チャンネルのピンチオフ特性を確認した。

## 3. 結果と考察 (Results and Discussion)

複数回のデバイス試作および解析を行い、デバイス構造を最適化するための検討を実施した。その結果、Fig. 1 に示す通り、ゲートにバイアスを印加する事で、チャンネルがピンチオフし、デバイスがオフ動作を示すことを確認した。

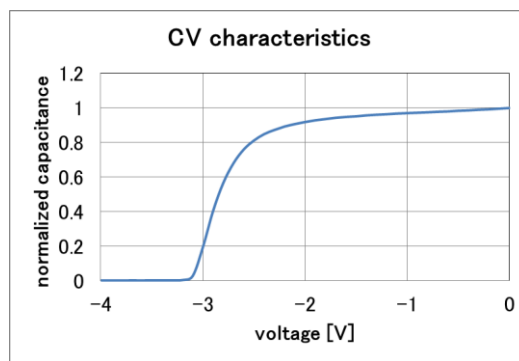


Fig. 1 CV characteristics

## 4. その他・特記事項 (Others)

今回の技術開発を通じて、多くの適切な助言を賜り、また丁寧にご指導いただいた津谷大樹氏、大里啓孝氏に感謝いたします。

## 5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

## 6. 関連特許 (Patent)

なし。